Ta₂O₅ 薄膜的低能离子辅助蒸镀

周九林 张 苑 杨德利

(西南技术物理研究所)

提 要

用低能氧离子辅助蒸镀技术,制备了一系列 Ta₂O₅ 薄膜。观测了薄膜的微结构,测量了薄膜的光吸收和**壳** 散射。实验指出,离子束轰击和基片加热同时进行,能够制得透明而匀均的 Ta₂O₅ 薄膜。 关键词: 薄膜微结构; Ta₂O₅ 薄膜; 离子辅助蒸镀。

一、引 言

近年来,离子辅助蒸镀技术在薄膜光学中得到了日益扩大的应用。离子辅助技术可以 改变薄膜的微结构,改进薄膜的特性,改善薄膜的应力状态。研究离子辅助蒸镀对某些光学 薄膜的性能的影响的文章很多^[1~6]。但是迄今为止,很少有文献详尽报道关于 Ta₂O₅ 薄膜 的离子辅助蒸镀实验^[7]。

Ta₂O₅ 薄膜结构致密,表面平滑,是一种优质的光学薄膜材料。从 1979 年开始,才见这方面的报道^[8]。

Ta₂O₅的蒸发性能稳定,在成膜过程中折射率几乎没有变化。而且,它还可以作为一种 稳定剂掺入到别的氧化物膜料中,以改善薄膜的特性。例如,将 Ta₂O₅ 混入 ZrO₂中,可以 消除纯 ZrO₂ 薄的复向非均匀性,制得折射率恒定的均匀薄膜^[9]。

值得注意的是, 文献[10] 报道了 33 层 Ta₂O₅/SiO₂ 可见光反射膜、最大反射率为 $R_m = 0.9996 \pm 0.0002$ 。并且可以做到使 Ta₂O₅ 薄膜的吸收和散射损耗都很小。近年来用离子束 微射技术制备了 Ta₂O₅ 薄膜^{C1~133}, 它显示了极其优越的光学性能。 在可见区, 消光 系 数 $k < 10^{-4}$, 折射率 n = 2.18, 而且没有色散。因此,实验研究 Ta₂O₅ 浓膜的离子辅助蒸镀, 探 索最佳的成膜条件, 无疑是很有实用意义的。

本文用低能氧离子辅助蒸镀技术,制备了 Ta₂O₅ 薄膜。对薄膜的微结构、光散射和光吸 收进行了一系列的实验研究。离子束能量低于 250 eV。实验发现,要制得无吸收的 Ta₂O₅ 薄膜,必需使离子束轰击和基片加热同时进行。

二、实 验

实验在光学镀膜机 DMD-450 中进行。蒸镀前的背景真空度 为(1~3)×10⁻⁵ Torr, 离 子源工作时的真空度为(1~2)×10⁻⁴ Torr。纯度为 99.99% 的膜料 Ta₂O₅ 用 L 型直射电子

收稿日期: 1987 年5 月 4 日; 收到修改稿日期: 1987 年 7 月 3 日

枪蒸发,蒸镀速率为3~5Å/sec。

离子束由我们实验室自制的 Kaufman 型单栅离子源产生。 单栅离子源的特点是,束 流密度大,离子束能量低,这往往是制备光学薄膜所需要的,因为过高的离子能量会引起再 溅射而造成薄膜的乏氧性^{口, a,n}。此外,单栅源远避免了多栅系统结构上"对栅"的困难。

离子束出口直径为4cm,没有装设专门的电荷中和器。实验发现,L型电子枪工作时, 次级电子具有明显的中和作用。

Ta₂O₅ 薄膜镀在 K_• 光学玻璃基片上,同时为了分析薄膜的微结构,薄膜也镀在透射电 镜专用的铜网上。透射电镜型号为 JGM-100X。薄膜的光谱透镜曲线用日立 340 分光光度 计测量。薄膜的光散射用清华大学精仪系的激光散射仪测量。

三、结 果

表1列出了几种 Ta₂O₅ 薄膜样品的镀制条件。样品序号统贯下文的所有实验资料。

Sample No.	lon type	Pressure (O ₁) (Torr)	Substrate temperature (°C)	Ion energy (eV)	Current density (µA/cm²)	Film thickness (nm)
1		2×10-4	150	_	0	≈130
2	O ₂ ⁺ /O ⁺	2×10^{-4}	Ambient	140	53	≈130
3	O ₂ ⁺ /O ⁺	2×10-4	Ambient	230	105	≈130
4	O ₂ ⁺ /O+	2×10-4	150	220	158	≈130
5*	O_{2}^{+}/O^{+}	2×10-4	150	140	263	≈130
6	02+/0+	2×10-4	150	220	158	628

Table 1 Deposition coditions of Ta₂O₅ films

* Note: The ion beam broke off prior to the thickness prescribed.

1. 薄膜的微结构

为节省篇幅,我们仅在图1列示出样品1和样品4的透射电镜显微照片。图的上部是 电子衍射图,下部是表面形貌图。可以看到,未经离子轰击的常规工艺蒸镀的Ta2Os薄膜, 其表面形貌细腻,但呈现大量的脉路式的沟壑,而经离子轰击后,柱体变得粗大,但却排列得 更紧密。随着离子流密度增高,柱体变得更加粗大。未经离子轰击的Ta2Os薄膜,呈现典型 的无定形结构;而经离子轰击后,随着离子能量增大,柱体排列的序化开始出现,取向程度逐 步提高。

对于基片不加热的 TasOs 薄膜, 经离子轰击后(样品 2 和 3), 透射电镜形貌图显示出极大的不均匀性, 膜面出现大块的"菌斑"。

2. 薄膜的光吸收

图 2、图 3 和图 4 是不同条件下镀制的 Ta₂O₅ 薄膜的透射光谱曲线。图中各曲线的标 号与表 1 的样品序号相对应。

曲线1是用常规工艺镀制的 Ta₂O₅ 薄膜的光谱透射率,即基片加热(150°C),同时通入 氧气。显然,薄膜具有明显的光吸收。

曲线2和3都是在蒸镀薄膜时基片不加温,但用了氧离子轰击。可以看到,这样的薄膜



Fig. 1 Transmission electron micrographs and diffraction patterns of Ta_2O_5 films. (a) sample No. 1 deposited at substrate temperature 150°C without ion bombardment; (b) sample No. 4 deposited at substrate temperature 150°C with ion bombardment of beam energy 220 eV, current density 158 μ Acm⁻²



依然有大的吸收,只不过随着氧离子能量和束流密度加大,吸收有所减小。

曲线4 反应了比较完善的镀制工艺。那就是蒸镀薄膜时,基片加热,同时施用氧离子轰击,这样可以制得光学透明的 Ta₂O₅ 薄膜。

非常有趣的是样品 5。薄膜蒸镀时基片加热,同时也用了氧离子轰击,但在膜层达到规定的厚度之前,由于偶然原因离子流中断,于是在没有氧离子辅助的情况下,在中性氧中镀完了膜层。曲线 5 表明,这样的薄膜具有微弱的光吸收。

图 5 表示出样品 6 的透射率光谱曲线。 样品 6 的成膜条件与样品 4 相同,只不过有意 使成厚膜,其几何厚度为 628 nm。由图可见, 低能氧离子辅助蒸镀 的 Ta₂O₅ 薄膜 是 均 匀 的, 而经氧离子轰击的 TiO, 薄膜却依然存在 ¹⁰⁻² -2.1





Fig. 6 Dispersion curves of refractive index and extinction coefficient of Ta_2O_5 film sample No. 4, 6

根据图 5 的曲线,我们采用透射率极值包络法¹¹¹,求解出薄膜样品 6 的折射率 n 和消 光系数 k,如图 6 所示。应当注意,薄膜的基片温度仅仅 150℃,而通常的氧化物成膜基片 温度为 250~300℃。若将 Ta₂O₅ 薄膜的基片温度适当提高,消光系数 k 必将进一步减小, 也就是说曲线 k~λ 会向短波方面移动。

3. 薄膜的光散射

薄膜的光散射直接与薄膜的微结构性质相关联。金属薄膜的光散射仅仅取决于薄膜的 表面微结构,而介质薄膜的光散射则由体内散射和表面散射两部分组成。

低能离子束对成长中的薄膜进行轰击,通过动量传递,使膜料淀积原子(分子)的迁移率 增大,有利于减少薄膜结构的缺陷,同时适当的离子束轰击,对薄膜表面形貌也有"熨平"作 用。离子束对薄膜结构和表面的修饰作用,有可能减小薄膜的光散射损耗。

任何一个起伏的表面,都可描述为许多个不同空间频率的组合。若能测出薄膜不同空间频率的散射相对值,则可以得到更多的结构信息。我们用激光散射仪只能测得薄膜的积分散射值,也就是 Ta₃O₅ 薄膜在经离子束轰击与不轰击的各种情况下,积分散射值的变化。虽然积分散射测量不能区分薄膜表面高、低空间频率的结构变化,但完全可以反应离子束轰击对散射的影响。表 2 列出表 1 中的几种 Ta₂O₅ 薄膜样品的积分散射值。这些薄膜镀在同一批抛光的 K₀ 玻璃片上,使薄膜衬底表面状况尽量一致。

由表可见,对热基片薄膜,离子束轰击使光散射明显减小。对照图1(a)和(b)的形貌照 片,我们可以合理地推想,热基片使膜料的淀积分子(原子)具有一定的迁移率,离子束轰击 使迁移率大大提高,其结果使薄膜的结构更密实,体内散射减小,并且淀积分子(原子)将充

报

No.	Substrate temperature (°C)	Ion energy $(e\nabla)$	Current density (µA/cm ²)	Scatt (:

Table 2 Integral scattering values of Ta₂O₅ films

Sample No.	Substrate temperature (°C)	Ion energy ($e\nabla$)	Current density (µA/cm ²)	Scatter ratio (10 ⁻⁴)
1	150		0	4.8
2	Ambient	140	53	4.5
3	Ambient	230	105	3 <i>.</i> 7
4	150	220	158	3.1

分地填补那些脉络状的沟壑,降低高空间频率的光散射;同时离子束对表面的"熨平"作用还 能消除其它散射缺陷,这些都是压抑光散射的有利影响。但是另一方面,离子轰击又使薄膜 柱体变得粗大,柱体边界成为新的散射源,随着离子能量和束流密度增大,柱体边界的散射 贡献进一步增长,这又是有害的倾向。因此,在有利影响和有害倾向之间必然存在一个最佳 状态,即离子能量和束流密度取某一最佳值,使薄膜的光散射损耗最小。

四、结 语

从上述实验可以认为:

1. 低能氧离子轰击与基片加热同时进行,可以制得透明的、均匀的 TasOs 薄膜。

 适当的离子轰击能够压抑 Ta₂O₅ 薄膜的光散射。就减小散射而论,离子束能量和束 流密度应当有最佳值,使薄膜的光散射为最小。

3. Ta2Os 薄膜在成膜时有一个氧化过程,要完成完全氧化过程,形成化学计量学组成 的 Ta₂O₆ 薄膜, 必需有足够的反应能量。基片加热是反应能量的重要来源。原则上讲, 对反 应能量作化学动力学估算应该是不能的。

参考文献

[1] P. J. Martin et al.; Appl. Opt., 1983, 22, No. 1 (Jan), 178.

[2] J. R. McNeil et al.; Appl. Opt., 1984, 23, No. 4 (Feb), 552.

- [3] J. B. McNeil et al.; Appl. Opt., 1985, 24, No. 4 (Feb), 486.
- [4] G. A. Al-Jumaily et al.; J. Vac. Sci. Technol. A. 1985, 3, No. 3 (May-Jun), 651.
- [5] P. J. Martin et al.; J. Appl. Phys., 1984, 55, No. 1 (Jan), 235.
- [6] B. P. Netterfield et al.; Appl. Opt., 1985, 24, No. 14 (Jul), 2267.
- [7] J. J. McNally et al.; J. Vac. Sci. Technol. A, 1986, 4, No. 3 (May-Jun), 437.
- [8] P. Baumeister; Appl. Opt., 1979, 18, No. 1 (Jan), 111.
- [9] USP 3783010.
- [10] O. Arnon, P. Baumeister; Appl. Opt., 1978, 17, No. 18 (Sep), 2913.
- [11] H. Demiryont et al.; Appl. Opt., 1985, 24, No. 4 (Feb), 490.
- [12] S. M. Rossnagel, J. R. Sites; J. Vac. Sci. Technol. A, 1984, 2, No. 2 (Apri-Jun), 376.
- [13] J. B. Sites et al.; J. Vac. Sci. Technol. A, 1985, 3, No. 3 (May-Jun), 654.

Low-energy ion-assisted deposition of Ta₂O₅ films

ZHOU JIULIN, ZHANG WAN AND YANG DELI (South-West Technical Physics Institute, Chengdu)

(Received 4 May 1987; revised 3 July 1987)

Abstract

A series of Ta_2O_5 films have been made by low-energy oxygen-ion assisted deposition. The microstructures of the films have been observed. The optical absorptance and scattering have been measured too. Experiments show that transparent and homogeneous Ta_2O_5 films can be obtained only if ion bombardment and heating of the substrate are performed simultaneously during deposition.

Key words: film microstructure; Ta₂O₅ films; ion assisted deposition.

5 期